



# 肖特基二极管芯片

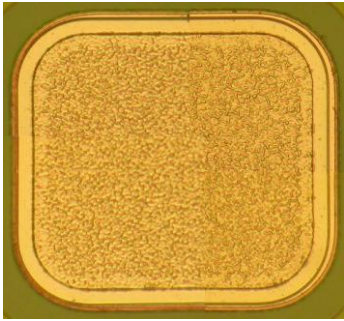


## M2CZ02T30ALJ15

### 产品概述

硅 N 型外延工艺肖特基二极管，终端采用保护环结构；具有功耗小、效率高、抗 ESD 及浪涌能力强的特点，广泛应用于开关电源、极性保护电路等各类电子线路中

### 芯片数据

芯片示意图	芯片版图尺寸(mm×mm)	0.32×0.32
	芯片厚度(μm)	150
	键合区面积(mm <sup>2</sup> )	0.23×0.23
	正面电极表层金属电极总厚度	铝/4.9μm
	背面电极表层金属电极总厚度	金/2.1μm
	硅片直径(mm)	φ 150
	装片要求	共晶

### 极限值 (除非另有规定, T<sub>a</sub>= 25°C)

参数名称	符号	额定值	单位	推荐封装形式
可重复峰值反向电压	V <sub>RRM</sub>	30	V	SOD-523
直流阻断电压	V <sub>R</sub>	30	V	
平均整流电流	I <sub>F(AV)</sub>	200	mA	
不重复峰值浪涌电流	I <sub>FSM</sub>	0.6	A	
结温	T <sub>j</sub>	125	°C	
贮存温度	T <sub>stg</sub>	-55~125	°C	

### 电参数 (除非另有规定, T<sub>a</sub>= 25°C)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
正向压降	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =10mA			0.3	V
	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =100mA			0.45	V
	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =200mA			0.52	V
反向漏电流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =10V			20	μA
	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =30V			80	μA
反向击穿电压	V <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =500μA	30			V

### 有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸酯 DEHP	邻苯二甲酸丁酯 DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
硅片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
正面金	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
背面金	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。									

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编：214061

网址：<http://www.crhj.com.cn>

电话：0510-8580 7228

传真：0510-8580 0864

市场营销部

邮编：214061

电话：0510-8180 5277 / 8180 5336

传真：0510-8580 0360 / 8580 3016